

Silicon Diode

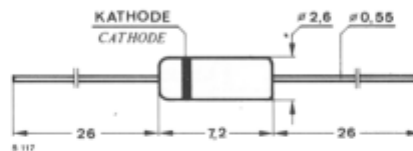
BAY92

600V / 100mA

DATASHEET

OEM – Telefunken

Source: Telefunken Databook 1977

BAY 92**Silizium-Diffusions-Diode**
Silicon diffusion diode**Anwendungen:** Schnelle Schalter, für hohe Betriebsspannungen**Applications:** Fast switches, with high supply voltages**Abmessungen in mm**
Dimensions in mm

Normgehäuse
Case
51 A 2 DIN 41 880
JEDEC DO 7
Gewicht · Weight
max. 0,2 g

Absolute Grenzwerte
Absolute maximum ratings

Periodische Spitzensperrspannung <i>Repetitive peak reverse voltage</i>	U_{RRM}	650	V
Sperrspannung <i>Reverse voltage</i>	U_R	600	V
Stoßdurchlaßstrom <i>Surge forward current</i>			
$\frac{t_p}{T} \leq 0,02, t_p \leq 1 \text{ ms}$	I_{FSM}	1	A
Periodischer Durchlaßspitzenstrom <i>Repetitive peak forward current</i>	I_{FRM}	200	mA
Durchlaßstrom <i>Forward current</i>	I_F	100	mA
Verlustleistung <i>Power dissipation</i> $l = 4 \text{ mm}, t_L \leq 25^\circ\text{C}$	P_V	230	mW
Sperrschichttemperatur <i>Junction temperature</i>	t_j	150	°C
Lagerungstemperaturbereich <i>Storage temperature range</i>	t_{stg}	-65...+150	°C

BAY 92

Wärmewiderstand <i>Thermal resistance</i>		Min.	Typ.	Max.
Sperrschicht-Umgebung <i>Junction ambient</i> $l = 4 \text{ mm}, t_L = \text{konstant}$ <i>constant</i>	R_{thJA}			450 °C/W
Kenngrößen <i>Characteristics</i>				
$t_j = 25^\circ\text{C}$				
Durchlaßspannung <i>Forward voltage</i> $I_F = 100 \text{ mA}$	$U_F^*)$			1 V
Sperrstrom <i>Reverse current</i> $U_R = 600 \text{ V}$	$I_R^*)$	0,25	1	μA
Diodenkapazität <i>Diode capacitance</i> $U_R = 10 \text{ V}, f = 1 \text{ MHz}$	C_D		2,5	4 pF
Rückwärtserholzeit <i>Reverse recovery time</i> $I_F = I_R = 10 \text{ mA}, i_R = 1 \text{ mA}, R_L = 100\Omega$	t_{rr}		350	500 ns

*) AQL = 0,65%